

2005年2月7日

委員各位

独立行政法人 日本学術振興会
「結晶加工と評価技術」第145委員会
委員長 梅野 正隆

独立行政法人 日本学術振興会
「結晶加工と評価技術」第145委員会 第102回研究会

テーマ：「GaN系およびZnO系半導体の結晶工学とデバイス」

日時： 2005年3月10日（木） 午後1時から午後5時30分

場所： 弘済会館「さくらの間」

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1、 TEL: 03-5276-0333

JR 四ツ谷駅下車 徒歩5分

地下鉄丸の内線四ツ谷駅下車徒歩5分、または地下鉄有楽町線麹町駅下車徒歩2分

世話人： 松本 智（慶応大学 理工学部）

プログラム

- (1) III族窒化物半導体の結晶成長および今後の課題 13:05~13:40
岩谷 素顕、上山 智、天野 浩、赤碕 勇（名城大学）
- (2) Si基板上のGaN成長とデバイス作製（仮） 13:40~14:15
大塚 康二（サンケン電気）
- (3) サブバンド間遷移を応用したGaN光スイッチの作製 14:15~14:50
飯塚 紀夫（東芝）
- (4) GaN高周波デバイス HEMT（仮） 14:50~15:25
吉川 俊英（富士通）

休憩 15:25~15:45

- (5) 酸化亜鉛の電子素子への応用 15:45~16:20
~バルク単結晶特性と界面特性の制御~ 大橋 直樹（物質・材料研究機構）
- (6) MBE法によるZnO結晶成長と物性制御 16:20~16:55
加藤 裕幸（スタンレー電気）
- (7) ZnOナノドットの自己形成と配列制御 16:55~17:30
藤田 静雄（京都大学）
- (8) 委員総会 17:30~

以上